

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникации

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИФНиТ



С.Б. Макаров

«28» сентября 2018 г.

ПРОГРАММА

**вступительного испытания для поступающих в магистратуру по
направлению подготовки/ образовательной программе:**

11.04.04 Электроника и нанoeлектроника /

11.04.04_06 Интегральная электроника и микросистемотехника

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

Санкт-Петербург

2018

Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки: 11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника», вошедших в содержание билетов вступительных испытаний в магистратуру.

Составители:

Доцент ВШПФиКТ

 / В.В. Лобода /

руководитель ОП 11.04.04_06

 / Т.Ю. Кудряшова /

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию методическим советом ИФНиТ (протокол № 2 от «25» сентября 2018 г.).

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

- 1.1. Материалы электронной техники
- 1.2. Физические основы электроники
- 1.3. Теория электрических цепей
- 1.4. Схемотехника

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. «Материалы электронной техники»

1. Физическая природа электропроводности металлов, сплавов, полупроводников и диэлектриков

Элементы и законы геометрической кристаллографии. Влияние вида симметрии на возможность возникновения свойств. Характеристические группы кристаллографических видов симметрии. Классы кристаллов. Химическая связь в кристаллах. Основные типы химической связи. Сильная и слабая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Металлическая связь. Связь Ван-дер-Ваальса. Элементы зонной теории твердого тела. Энергетические зоны. Распределение электронов. Металлы, полупроводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории. Химическая связь и электронные свойства материалов. Основные типы кристаллических структур. Дефекты в кристаллических твердых телах.

2. Проводниковые материалы

Проводники первого и второго рода. Физическая природа электропроводности металлов и ее свойства. Тепловые свойства металлов. Электрические свойства металлических сплавов. Контактные явления и термо-ЭДС.

3. Полупроводниковые материалы

Физические процессы в полупроводниках и их свойства и характеристики. Собственные и примесные полупроводники. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Классификация полупроводниковых материалов. Элементы, обладающие свойствами

полупроводников, полупроводниковые химические соединения и материалы на их основе.

4. Диэлектрические материалы

Поляризация диэлектриков. Токи смещения и электропроводность диэлектриков. Потери в диэлектриках. Пробой в диэлектриках. Классификация диэлектриков. Пассивные и активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики.

5. Магнитные материалы

Классификация магнитных материалов. Ферромагнетики.

Литература для подготовки:

1. Материалы электронной техники: учеб. для вузов по спец. электронной техники / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин.— Изд. 5-е, стер.— Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2003.— 367 с.: ил. — (Учебники для вузов: Специальная литература).— Библиогр.: с. 361.
2. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учеб. пособие для вузов по направл. 654200 - "Радиотехника" / К. С. Петров .— Москва [и др.] : Питер, 2006 .— 521 с.: ил. — (Учебное пособие) .— Издательская программа: 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга .— Библиогр.: с. 512-513.

2.2. « Физические основы электроники»

1. Электронно-дырочный переход

Идеализированный электронно-дырочный переход. Реальный электронно-дырочный переход. Зависимость параметров перехода от концентрации примесей и электронных свойств полупроводников. Прямое и обратное смещение р-п – перехода. Электрический и тепловой пробой перехода. Емкость электронно-дырочного перехода. Нестационарные процессы в р-п – переходе. Электронно-дырочный переход на основе вырожденных полупроводников. Переход на основе р- и п-полупроводников с критической концентрацией примесей

2. Контакт металл-полупроводник

Свойства идеального контакта металл-полупроводник при отсутствии поверхностного заряда. Омический и выпрямляющий контакты. Вольт-амперная характеристика выпрямляющего контакта. Влияние

поверхностного заряда полупроводника на свойства контакта. Применение омических и выпрямляющих контактов в полупроводниковой электронике

3. Гетеропереходы

Анизотипные (р-п) и изотипные гетеропереходы. Энергетические диаграммы. Особые свойства гетеропереходов. Односторонняя инжекция неосновных носителей в гетеропереходах. Применения гетеропереходов.

4. Полупроводниковые диоды

Особенности устройства и работы полупроводниковых диодов: выпрямительных, универсальных, импульсных, сверхвысокочастотных, стабилитронов, варикапов, туннельных и обращенных диодов, диодов Шоттки. Вольтамперные характеристики диодов различного назначения. Основные параметры полупроводниковых диодов. Классификация и условные обозначения полупроводниковых диодов.

5. Биполярные транзисторы

Устройство, принципы и режимы работы, схемы включения. Основные физические процессы в биполярном транзисторе. Активный режим работы биполярного транзистора. Статические характеристики биполярного транзистора при включении по схемам с общей базой и с общим эмиттером. Биполярный транзистор как линейный четырехполюсник. Система h -параметров. Усилительные свойства биполярных транзисторов в различных схемах включения. Влияние температуры характеристики и усилительные свойства биполярных транзисторов. Работа биполярного транзистора в режиме ключа, его частотные и импульсные свойства. Классификация и условные обозначения биполярных транзисторов.

6. Полевые транзисторы

Полевые транзисторы, их типы, устройство, схемы включения. Полевые транзисторы с управляющим электронно-дырочным переходом и переходом металл-полупроводник: физический принцип действия, характеристики и параметры. Полевые транзисторы с изолированным затвором: механизм образования индуцированного или встроенного канала. Вольтамперные характеристики и параметры. Классификация и условные обозначения полевых транзисторов. Приборы с зарядовой связью, их устройство, принцип работы и назначение.

Литература для подготовки:

1. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров, магистров и дипломированных

специалистов "Электроника и микроэлектроника" / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин .— Изд. 9-е, стер. — СПб. [и др.] : Лань, 2009 .— 478, [1] с.: ил. ; 23 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 460.

2. Основы микроэлектроники : [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко .— Изд. 2-е, [перераб. и доп.] .— Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.: ил. ; 22 см .— (Технический университет, Электроника) .— Библиогр.: с. 488.

2.3. « Теория электрических цепей»

1. Основные понятия и законы теории электрических цепей.

Идеализированные элементы электрической цепи: пассивные сопротивление, индуктивность, емкость; активные – источники напряжения и тока. Способы описания свойств элементов электрической цепи: статические характеристики, дифференциальные параметры, эквивалентные схемы резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности при разных частотах. Законы Кирхгофа. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

2. Линейные электрические цепи в режиме гармонического тока

Периодические токи и напряжения. Гармонические токи и напряжения. Действующие и средние значения гармонических токов и напряжений. Метод комплексных амплитуд. Изображение гармонических функций, их интегралов и производных комплексными величинами. Комплексная амплитуда. Комплексные сопротивления и проводимости; активные и реактивные сопротивления и проводимости. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Векторная диаграмма. Комплексная мощность, активная и реактивная мощность. Условие передачи максимума мощности от генератора в нагрузку

3. Преобразование схем электрических цепей

Последовательное соединение двухполюсников, параллельное соединение двухполюсников. Эквивалентные участки цепи с последовательным и параллельным соединением. Эквивалентность источников тока и напряжения. Преобразование схемы с двумя узлами.

4. Методы расчета сложных электрических цепей

Применение законов Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Теорема взаимности. Теоремы об эквивалентном генераторе тока и напряжения. Расчет цепей со взаимной индуктивностью. Индуктивность

рассеяния. Коэффициент связи. Линейный трансформатор. Идеальный трансформатор. Устройство автотрансформатора. Эквивалентная схема двухконтурной цепи с трансформатором.

5. Резонансные явления в электрических цепях

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре. Явление резонанса. Резонанс напряжений. Уравнение резонансной кривой. Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре. Резонанс токов. Входное сопротивление контура при резонансе и в области малых расстройек. Влияние внутреннего сопротивления источника на характеристики резонансной системы. Приведенная добротность. Сложные контуры. Коэффициент включения. Фильтрующие свойства резонансных контуров. Связанные контуры Резонансные кривые связанных контуров. Полоса пропускания связанных контуров. Связь апериодического контура с колебательным.

Литература для подготовки:

1. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электр. цепей. учеб. пособие для вузов по направл. 550000 - "Технические науки", 650000 - "Техника и технологии" и дисциплине "Теоретические основы электротехники". / А. Б. Новгородцев — М. [и др.] Питер, 2006
2. Теоретические основы электротехники. учебник для вузов по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". [в 3 т.]. / К. С. Демирчян [и др.] — М. [и др.] Питер, 2006

2.4. «Схемотехника»

1. Усилители на биполярных транзисторах

Принципиальная схема усилителя. Понятие "рабочая точка". Установка рабочей точки, термостабилизация. Анализ транзисторного усилителя на основе малосигнального приближения. Эквивалентные малосигнальные схемы биполярного транзистора. Анализ усилителя на БТ (схема ОЭ): коэффициент усиления, входное сопротивление.

2. Усилители с отрицательной обратной связью

Стабилизация рабочей точки и параметров усилителей. Усилитель с отрицательной обратной связью. Основы расчетов усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Эмиттерный повторитель. Каскадные схемы.

3. Усиление сигналов на высоких частотах

Особенности транзистора на высоких частотах. Эффект Миллера. Схемы с ОЭ и ОК на высоких частотах. Каскодные схемы.

4. Усилители и ключи на полевых транзисторах (МОП транзисторах)

Усилитель на полевом транзисторе (схема ОИ). Анализ усилителя на основе малосигнального приближения: малосигнальные параметры ПТ, приближенная оценка, эквивалентные малосигнальные схемы ПТ. Коэффициент усиления в схеме ОИ. Основы расчетов усилительных каскадов на полевых транзисторах. МОП-ключ: принцип построения, схема, передаточная характеристика.

5. Генераторы стабильного тока на транзисторах

Генераторы стабильного тока на транзисторах: идея, области применения в транзисторных усилителях. ГСТ на полевом транзисторе. Усилитель на ПТ с динамической нагрузкой. Токовое зеркало. Применения токовых зеркал для задания рабочей точки усилителя и в качестве динамической нагрузки.

6. Дифференциальные усилители

Принцип построения дифференциального усилителя. Схема ДУ, режимы больших и малых сигналов. Коэффициент усиления, подавление синфазной составляющей. Схемы дифференциального усилителя с генератором стабильного тока. Специфика применения ДУ в интегральной схемотехнике (схемная симметрия). Подавление помех. Применение ДУ в качестве аналогового умножителя.

7. Операционные усилители и схемы на ОУ

Понятие операционного усилителя, характеристики, параметры. Модель идеального усилителя. Неинвертирующий и инвертирующий усилители. Принцип отрицательной обратной связи. Дифференциальный усилитель на ОУ. Сумматор на ОУ. Функциональные преобразователи на ОУ, интегратор и дифференциатор. Преобразователи импеданса на ОУ, гиратор. Частотные свойства операционного усилителя. Частотные свойства неинвертирующего усилителя. Устойчивость неинвертирующего усилителя. Частотные свойства ОУ без частотной коррекции. Назначение частотной коррекции, её влияние на устойчивость неинвертирующего усилителя.

8. Автогенераторы на ОУ, компараторы

Автогенераторы гармонических колебаний на ОУ: принцип действия, схемы, условия устойчивости. Компараторы: понятие, передаточные характеристики, гистерезис. Триггеры Шмитта на ОУ. Мультивибраторы на ОУ.

9. Аналого-цифровые преобразователи

Дискретизация по времени, квантование по уровню и кодирование аналогового сигнала. Классификация и характеристики АЦП. Структурные схемы АЦП различных типов.

10. Цифро-аналоговые преобразователи

Классификация ЦАП. Резистивные матрицы: R-2R и с весовыми коэффициентами; разрядность и разрешающая способность ЦАП.

Литература для подготовки:

1. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. / У. Титце и К. Шенк
Издательство: ДМК Пресс. 2008. в 2х томах. Т1 1 832с. Т2 942с
2. Основы микроэлектроники : [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко .— Изд. 2-е, [перераб. и доп.] .— Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2004 .— 488 с.: ил. ; 22 см .— (Технический университет, Электроника) .— Библиогр.: с. 488.

3. ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

по направлению подготовки/ образовательной программе:

11.04.04 Электроника и нанoeлектроника /

11.04.04_06 Интегральная электроника и микросистемотехника

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ Т.Ю. Кудряшова

«20» июня 2019 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Физические процессы в полупроводниках и их свойства и характеристики. Собственные и примесные полупроводники. (50 баллов).
2. Последовательное соединение двухполюсников, параллельное соединение двухполюсников. Эквивалентные участки цепи с последовательным и параллельным соединением. (50 баллов).